

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段
一號

承辦人：賴建成

電話：2771-2171#6020

電子信箱：lks@ntut.edu.tw

受文者：國立臺中科技大學

發文日期：中華民國114年6月4日

發文字號：北科大產學字第1147900158號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：114年高功率半導體磊晶技術與應用教師研習營海報、114年高功率半導體磊晶技術與應用教師研習營課程表、114年高功率半導體磊晶技術與應用教師研習營海報 (114F900509_1_04161101340.pdf、114F900509_2_04161101340.pdf)

主旨：檢送本校與財團法人國家實驗研究院國家儀器科技研究中心合作辦理「高功率半導體磊晶技術與應用教師研習營」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校教師踴躍報名參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、依據技術及職業教育法第二十六條第一項規定：「技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技術教師，每任教滿六年應至與技職校院合作機構或與任教領域有關之產業，進行至少半年以上與專業或技術有關之研習或研究」，辦理教師實務研習課程。
- 二、為擴展半導體材料生長技術與應用領域，並促進技職校院教師之學術與實務能力並重，使其教學內容更貼近半導體材料生長技術與相關設備產業現況與趨勢，提升教師教學之品質與資源。本研習營透過專題講座、設備實作與經驗分享，協助教師掌握高功率半導體（如 GaN、SiC、AlN、

Ga203 等) 磊晶製程的最新技術發展、產業應用與未來挑戰，強化跨領域整合與創新思維能力。期望培育具備產學連結能力之師資，進一步提升我國技術人才培育的深度與廣度，推動半導體關鍵材料與製程技術自主發展。

三、報名資格：國內各大專校院及高中職在職教師。

四、課程時間：114年8月13日（三）、8月14日（四），共計2天，凡符合報名資格且全程參與課程者，將於課程結束後擇期核發研習時數證明電子檔。

五、人數上限：實體30人。

六、課程地點：國家實驗研究院國家儀器科技研究中心。

七、報名網址：<https://forms.gle/SsfZjUAQ6gLsnfXB9>

八、聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學賴專員，連絡電話：(02)2771-2171分機6020，電子郵件：
lks@mail.ntut.edu.tw

九、檢附「高功率半導體磊晶技術與應用教師研習營」課程表、海報。

正本：各公私立大專校院、各國立高級職業學校、各私立高級職業學校、各公私立高級中學

副本：財團法人國家實驗研究院國家儀器科技研究中心、本校產學合作處



114 年高功率半導體磊晶技術與應用教師研習營

課程時間：114 年 8 月 13 日（三）至 8 月 14 日（四）

課程地點：財團法人國家實驗研究院國家儀器科技研究中心
（新竹市科學園區研發六路 20 號）

課程人數：30 人

參與對象：全國各大專校院、高中職在職教師

報名網址：<https://forms.gle/SsfZjUAQ6gLsnfXB9>

報名 QR Code：



課程內容

日期	時間	課程內容	授課講師
8/13 (三)	08:30~09:00	報到	
	09:00~12:00	(超) 高功率半導體材料 成長技術與應用介紹	財團法人國家實驗研究院 國家儀器科技研究中心 陳維鈞 博士
	12:00 ~ 13:30	午餐	
	13:30 ~ 16:30	寬能隙化合物半導體 磊晶技術與應用	財團法人國家實驗研究院 台灣半導體研究中心 許隆興 博士
	16:30~18:00	綜合討論	
8/14 (四)	08:30 ~ 09:00	報到	
	09:00 ~ 12:00	新興半導體材料磊晶 技術與產業應用	國立彰化師範大學 柯宗憲 教授
	12:00 ~ 13:30	午餐	
	13:30~15:30	磊晶薄膜的繞射量測與分析	財團法人國家實驗研究院 國家儀器科技研究中心 丘坤安 博士
	15:30~16:30	磊晶製程與分析實驗室簡介	財團法人國家實驗研究院 國家儀器科技研究中心 陳維鈞 博士
	16:30~18:00	綜合討論	

114年高功率半導體 磊晶技術與應用 教師研習營



日期：114 年 8月13日(三)、8月14 日(四)

地點：財團法人國家實驗研究院國家儀器科技研究中心



主辦單位：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學
財團法人國家實驗研究院國家儀器科技研究中心